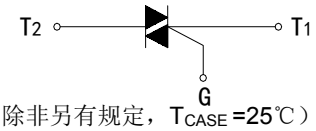
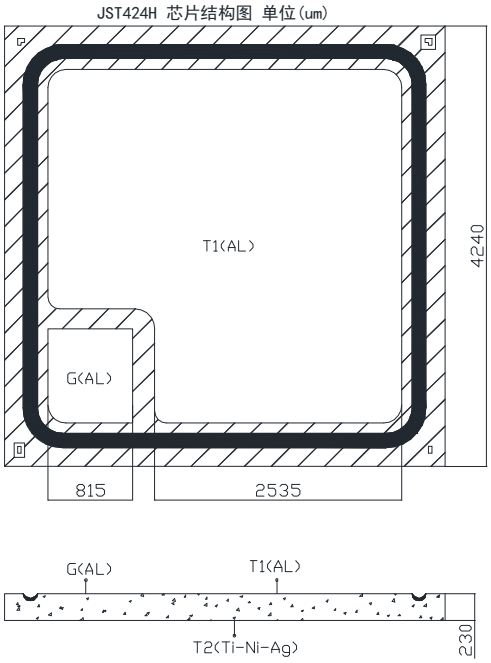
JST424H 高结温型三象限双向晶闸管芯片　　（芯片代码：CP308）

○ 芯片特征：单面台面结构，台面玻璃钝化工艺，背面三层金属电极。

○ 芯片尺寸：4.24mm×4.24mm

○ 可替换型号：BCR16PM





○产品极限参数（封装成 TO-220F 后，除非另有规定，T_{CASE} =25℃）

参数名称		符 号	数 值	单 位
结温范围		Tj	-40～150	℃
正向断态重复峰值电压		V_{DRM}	600/800	V
反向断态重复峰值电压		V_{RRM}	600/800	V
通态均方根电流　T_C=96℃		$I_{T(RMS)}$	16	A
通态浪涌电流	tp=20mS	I_{TSM}	160	A
	tp=16.7mS		168	
I^2t 值　　tp=10mS		I^2t	108	A^2S
通态电流临界上升率 I_G=2×I_{GT},tr≤100ns, F=100Hz		dI/dt	50	A/uS
门极峰值电流　　Tj=150℃		I_{GM}	2	A
门极平均功率　　Tj=150℃		$P_{G(AV)}$	1	W

○ 产品电性能（封装成 TO-220 后，除非另有规定，T_{CASE} =25℃）

特性和测试条件	符 号	数 值			单 位
		20	35	50	
通态峰值电压　I_{TM}=22.5A,tp=380uS	V_{TM}	≤1.55			V
正向断态峰值电流　　T_C=25℃	I_{DRM1}	≤5			uA
V_D=V_{DRM}　　T_C=150℃	I_{DRM2}	≤1.5			mA
反向断态峰值电流　　T_C=25℃	I_{RRM1}	≤5			uA
V_R=V_{RRM}　　T_C=150℃	I_{RRM2}	≤1.5			mA
门极触发电压　　V_D=12V, R_L=30Ω	V_{GT}	≤1.5			V
门极不触发电压 V_D=V_{DRM},　R_L=3.3KΩ,　　Tj=150℃	V_{GD}	≥0.2			V
门极触发电流　　V_D=12V, R_L=30Ω	I_{GT}(Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ)	≤20	≤35	≤50	mA
擎住电流	I_L（Ⅰ-Ⅲ）	≤40	≤50	≤70	
I_G= 1.2I_{GT}	I_L（Ⅱ）	≤55	≤70	≤100	mA
维持电流　　I_T=0.2A	I_H	≤30	≤45	≤60	mA
换向电压临界上升率 V_D=400V　　T(vj)=150℃ (di/dt)c=-7A/ms	(dV/dt)c	≥5	≥15	≥20	V/uS